

特許協力条約

P C T

18.2.15

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

(法第 12 条、法施行規則第 56 条)

[P C T 36 条及び P C T 規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 KD05001PCT--	今後の手続きについては、様式 P C T / I P E A / 4 1 6 を参照すること。	
国際出願番号 P C T / J P 2 0 0 5 / 0 0 2 4 9 5	国際出願日 (日.月.年) 17. 02. 2005	優先日 (日.月.年) 18. 02. 2004
国際特許分類 (I P C) Int.Cl. H01L51/05(2006.01), H01L21/336(2006.01), H01L21/363(2006.01), H01L29/786(2006.01)		
出願人 (氏名又は名称) 関東電化工業株式会社		

1. この報告書は、P C T 35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。
法施行規則第 57 条 (P C T 36 条) の規定に従い送付する。

2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。

3. この報告には次の附属物件も添付されている。

a. 附属書類は全部で 3 ページである。

振正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (P C T 規則 70.16 及び実施細則第 607 号参照)

第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙

b. 電子媒体は全部で _____ (電子媒体の種類、数を示す)。
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。
(実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

第 I 欄 国際予備審査報告の基礎
 第 II 欄 優先権
 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 第 IV 欄 発明の単一性の欠如
 第 V 欄 P C T 35 条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 第 VI 欄 ある種の引用文献
 第 VII 欄 国際出願の不備
 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 12. 08. 2005	国際予備審査報告を作成した日 01. 02. 2006
名称及びあて先 日本国特許庁 (I P E A / J P) 郵便番号 100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号	特許庁審査官 (権限のある職員) 宮崎 園子 電話番号 03-3581-1101 内線 3498
	4 L 9277

様式 P C T / I P E A / 4 0 9 (表紙) (2005年4月)

第I欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

出願時の言語による国際出願

出願時の言語から次の目的のための言語である _____ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文

国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))

国際公開 (PCT規則12.4(a))

国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

出願時の国際出願書類

明細書

第 1-9, 11-34 ページ、出願時に提出されたもの
 第 10 ページ*、23.08.2005 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ*、_____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの
 第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 第 6-7, 11-14 ページ*、23.08.2005 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ 項*、_____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

図面

第 1-3 ページ/図、出願時に提出されたもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの
 第 _____ ページ/図*、_____ 付けて国際予備審査機関が受理したもの

配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. 補正により、下記の書類が削除された。

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input checked="" type="checkbox"/> 請求の範囲	第 <u>1-5, 8-10</u>	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

<input type="checkbox"/> 明細書	第 _____	ページ
<input type="checkbox"/> 請求の範囲	第 _____	項
<input type="checkbox"/> 図面	第 _____	ページ/図
<input type="checkbox"/> 配列表 (具体的に記載すること)	_____	
<input type="checkbox"/> 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること)	_____	

* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N) 請求の範囲 6-7, 11-14 有
 請求の範囲 _____ 無

進歩性 (I S) 請求の範囲 6-7, 13-14 有
 請求の範囲 11-12 無

産業上の利用可能性 (I A) 請求の範囲 6-7, 11-14 有
 請求の範囲 _____ 無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 : Y. Sakamoto et al., Proc. 2003 MRS Fall Meeting, K10.52

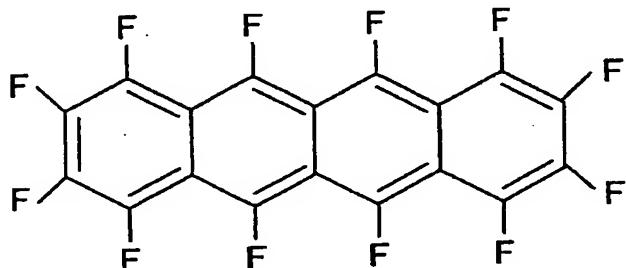
請求の範囲 11-12

請求の範囲1に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1より進歩性を有しない。アセン化合物を真空蒸着させることは周知である。

ラデカフルオロペンタセンを基板上に真空蒸着させることは、テトラデカフルオロペンタセンを基板の表面上に直接真空蒸着させて、基板の表面上に直接テトラデカフルオロペンタセンの薄膜を形成すること、及び基板の表面に別の層を形成した後、その基板に形成された別の層の表面上にテトラデカフルオロペンタセンを真空蒸着させて、基板に形成された別の層の表面上にテトラデカフルオロペンタセンの薄膜を形成することの両方を含む。このように、有機薄膜トランジスタの基板の温度を30°C以上65°C以下に制御すると共にテトラデカフルオロペンタセンを基板上に真空蒸着させて、テトラデカフルオロペンタセンからなる有機半導体層を形成することによって、テトラデカフルオロペンタセンの複数の分子が、比較的均一に配向した有機半導体層を得ることができる。また、この場合には、テトラデカフルオロペンタセンの複数の分子における分子平面が互いに略平行であり、テトラデカフルオロペンタセンの分子の長軸方向が、有機薄膜トランジスタの基板の表面に対して略垂直な方向に向いている。従って、高いキャリア移動度を有する有機薄膜トランジスタを製造することができる。

[0043] また、上記のフッ素化アセン化合物は、好ましくは、ドデカフルオロナフタセン ($C_{18}F_{12}$) である。すなわち、フッ素化アセン化合物は、式

[0044] [化2]



で表される化合物であり、この化合物は、式 $C_{4n+2}F_{2n+4}$ で表される化合物において $n=4$ の化合物である。上記のフッ素化アセン化合物が、ドデカフルオロナフタセンであることにより、高いキャリア移動度を有する有機薄膜トランジスタをより確実に提供す

請求の範囲

[1] (削除)

[2] (削除)

[3] (削除)

[4] (削除)

[5] (削除)

[6] (補正後) 基板及び有機半導体層を含む有機薄膜トランジスタの製造方法において、

前記有機半導体層は、前記基板の温度を30°C以上65°C以下に制御すると共にテトラデカフルオロペンタセンを前記基板上に真空蒸着させることによって得られることを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。

[7] (補正後) 基板及び有機半導体層を含む有機薄膜トランジスタの製造方法において、

前記有機半導体層は、前記基板の温度を24°C以上60°C以下に制御すると共にドデカフルオロナフタセンを前記基板上に真空蒸着させることによって得られることを特徴とする有機薄膜トランジスタの製造方法。

[8] (削除)

[9] (削除)

[10] (削除)

[11] (追加) 基板及び有機半導体層を含む有機薄膜トランジスタにおいて、

前記有機半導体層は、前記基板の温度を制御すると共に、式 $C_{4n+2}F_{2n+4}$ で表され、nが2以上の整数であるフッ素化アセン化合物を、前記基板上に真空蒸着させることによって得られることを特徴とする有機薄膜トランジスタ。

[12] (追加) ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、及びゲート絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請求項11に記載の有機薄膜トランジスタ。

[13] (追加) 前記基板の温度は、30°C以上65°C以下に制御され、

前記式フッ素化アセン化合物は、テトラデカフルオロペンタセンであることを特徴とする請求項11に記載の有機薄膜トランジスタ。

[14] (追加)

ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、及びゲート絶縁膜をさらに含むことを特徴とする請求項13に記載の有機薄膜トランジスタ。

注 意

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権情報・研修館（特許庁庁舎2階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号（特許庁庁舎2階）
独立行政法人工業所有権情報・研修館

【公 報 類】 閲覧部 T E L 03-3581-1101 内線3811～2
【公報以外】 資料部 T E L 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

(1) 特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

- 特許・実用新案及び意匠の種類
- 出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）
- 必要部数

(2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

- 国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

[申込み及び照会先]

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル
財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

T E L 03-3508-2313

注）特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）